

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成16年8月12日(2004.8.12)

【公開番号】特開2002-343842(P2002-343842A)

【公開日】平成14年11月29日(2002.11.29)

【出願番号】特願2001-215657(P2001-215657)

【国際特許分類第7版】

H 01 L 21/66

G 01 B 11/06

H 01 L 21/304

H 01 L 27/12

【F I】

H 01 L 21/66 P

G 01 B 11/06 Z

H 01 L 21/304 6 2 2 S

H 01 L 27/12 B

H 01 L 27/12 T

【手続補正書】

【提出日】平成15年7月24日(2003.7.24)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項2】

前記解析波長領域を設定する工程では、

前記酸化膜の屈折率を n_{ox} 、膜厚を d_{ox} とし、 m を任意の正数であるとすると、前記解析波長領域を示すとして、

【数1】

$$\frac{2 \cdot n_{ox} \cdot d_{ox}}{m - 0.98} > \lambda > \frac{2 \cdot n_{ox} \cdot d_{ox}}{m - 0.02}$$

を満たす範囲に設定することを特徴とする請求項1に記載の半導体層の膜厚測定方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0056

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0056】

【数13】

$$\frac{2 \cdot n_{ox} \cdot d_{ox}}{m - 0.98} > \lambda > \frac{2 \cdot n_{ox} \cdot d_{ox}}{m - 0.02}$$